
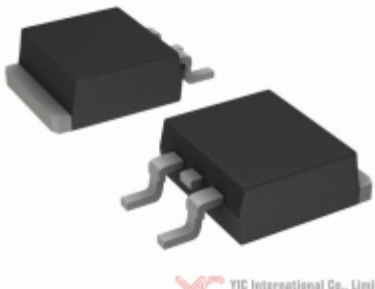
	<h2 style="color: red;">FQB8P10TM</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQB8P10TM</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 100V 8A D2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQB8P10TM.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 33814 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQB8P10TM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 100V 8A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	33814 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	3.75W (Ta), 65W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	530 mOhm @ 4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	470pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Original-Reel®

FQB8P10TM ist neu im Original, Suche FQB8P10TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQB8P10TM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQB8P10TM: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQB8N90CTM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 6.3A D2PAK</p>	 <p><b>FQB95N03L</b> FAIRCHI FAIRCHI SOT-263</p>	 <p><b>FQB8N90CTM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 6.3A D2PAK</p>	 <p><b>FQB8P10</b> FAIRCHI FQB8P10 FAIRCHI</p>
 <p><b>FQB9N08LTM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 9.3A D2PAK</p>	 <p><b>FQB9N08L</b> VB FQB9N08L VB</p>	 <p><b>FQB8N90C</b> FAIRCHI FQB8N90C FAIRCHI</p>	 <p><b>FQB8P10TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 8A D2PAK</p>

### heiße Teile

Mehr

 FQB6N70TM	 FQB6N90TM	 FQB6N90TM_AM002	D FQB6N90TM_AM002	 FQB7042FB
 FQB7045FB	 FQB70N03	D FQB70N06	 FQB70N08	 FQB70N10TM
 FQB7N10L	 FQB7N20L	 FQB7N60TM	 FQB7N60TM	 FQB7N65C
D FQB7N65CTM	 FQB7N65CTM	 FQB7P20TM	 FQB7P20TM	 FQB85N06
 FQB85N06TM	 FQB8N25TM	 FQB8N25TM	 FQB8N60C	 FQB8N60CFTM
 FQB8N60CFTM	 FQB8N60CTM	D FQB8N60CTM	 FQB8N60TM	 FQB8N90CTM
 FQB8N90CTM	D FQB8P10TM	 FQB8P10TM-NL	 FQB8N90L	 FQB8N90LTM
 FQB9N08LTM	 FQB9N25C	 FQB9N25CTM	 FQB9N25CTM	 FQB9N25TM
 FQB9N25TM	 FQB9N50C	 FQB9N50CFTM	D FQB9N50CFTM	 FQB9N50CTM
 FQB9N50CTM	 FQB9N50TM	 FQB9N50TM	 FQB9P25TM	 FQB9P25TM

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited